

01;07

## **О фокусировке сферической рентгеновской волны при обратном рассеянии кристаллом, изогнутым в форме параболического цилиндра**

© Т. Чен

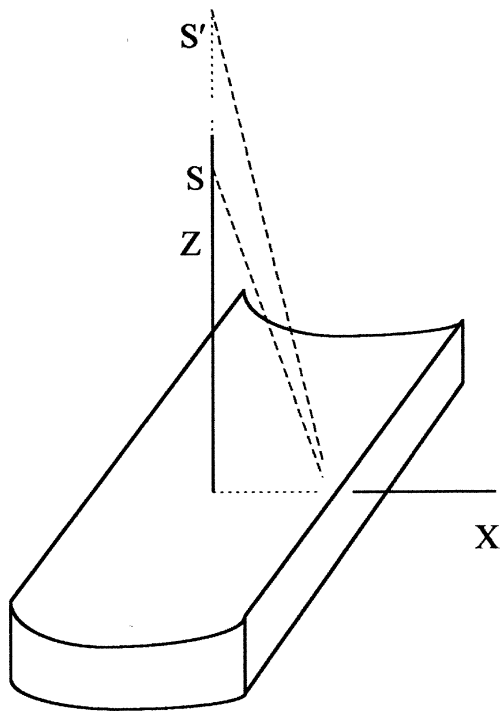
Московская государственная академия  
тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова  
E-mail: docent65@mtu-net.ru, ttchen@e-mail.ru

*Поступило в Редакцию 16 июля 2001 г.  
В окончательной редакции 19 ноября 2001 г.*

Теоретически исследуется фокусировка сферической рентгеновской волны при обратном брэгговском отражении от кристалла, одноосно изогнутого в форме параболического цилиндра. На основе геометрической оптики получена аналитическая формула для размера поверхности кристалла, участвующей в обратном дифракционном отражении. Проанализирована формула для распределения интенсивности вблизи фокуса. Проведено ее сравнение с ранее существовавшим в теории выражением.

Обратное рассеяние рентгеновского излучения ( $\theta_B = \pi/2$ ) при брэгговской дифракции на изогнутом кристалле отличается от „обычной“ дифракции ( $\theta_B \neq \pi/2$ ) тем, что размер  $2\Delta\theta \sim 2|\chi_{hr}|^{1/2}$  области полного отражения на 2–3 порядка больше. Здесь  $\theta_B$  — брэгговский угол,  $\chi_{hr}$  — фурье-компонента рентгеновской поляризуемости. Примерно во столько же раз возрастает светосила отраженного пучка. Кроме того, геометрические aberrации при обратном рассеянии минимизированы из-за нормального падения волны на кристалл. Указанные выше преимущества обратного рассеяния объясняют интерес к нему со стороны некоторых авторов [1–3].

В настоящей работе, используя геометрооптические представления, нами получено аналитическое выражение для нахождения размера области на поверхности изогнутого кристалла, дифракционно отражающей сферическую волну в обратном направлении. Кроме того, впервые



Принципиальная схема фокусировки сферической волны при обратном рассеянии цилиндрически изогнутым кристаллом:  $S$  — точечный источник,  $S'$  — его изображение.

получено аналитическое выражение для интенсивности вблизи фокуса, учитывающее члены  $\sim x^4$  в фазе отраженной волны.

Рассмотрим одноосно-изогнутый с радиусом изгиба  $R_x$  кристалл (см. рисунок). Обозначим угол между произвольным лучем, падающим на кристалл в точке с координатами  $(x, z \approx x^2/2R_x)$ , и осью  $X$  через  $\varphi_{0x}$ . Угол между отраженным лучем и осью  $Z$  обозначим  $\varphi_{0z}$ . Тогда при обратном рассеянии:

$$\begin{aligned} \cos \varphi_{0x} &\cong x/L_0 - x^3(1 - L_0/R_x)/2L_0^3, \\ \cos \varphi_{0z} &\cong -1 + x^2/2L_0^2 + x^4(1/R_x - 3/4L_0)/2L_0^3. \end{aligned} \quad (1)$$

Учтем, что  $\mathbf{k}_0 + \mathbf{h} = \mathbf{k}_h$ ,  $k_0^2 = k_h^2 = k^2$ ,  $h_0 = 2k \sin \theta_B$ ,  $\mathbf{h} = \mathbf{h}_0 - \nabla(\mathbf{h}_0 \mathbf{u})$ ,  $\mathbf{h}_0$  и  $\mathbf{h}$  — векторы обратной решетки неизогнутого и изогнутого кристаллов соответственно,  $\mathbf{u}(-xz/R_x, 0, x^2/2R_x)$  — вектор смещения отражающих плоскостей кристалла при упругом изгибе,  $\mathbf{k}_{0,h}$  — волновые векторы падающей и дифрагированной волн.

Тогда для угловой полуширины кривой брэгговского отражения находим:

$$\Delta\theta = \left| 2x^2/R_x L_0 + x^2/L_0^2 + x^2/R_x^2 + x^4/2R_x^2 L_0^2 - 3x^4/4L_0^4 - x^4/R_x^3 L_0 - 3x^4/4R_x^4 \right|^{1/2}. \quad (2)$$

Анализ выражения (2) для случая плоской волны ( $L_0 \gg R_x$ ) дает:

$$\Delta\theta = |x^2/R_x^2 - 3x^4/4R_x^4|^{1/2}. \quad (3)$$

При  $x^2/R_x^2 \ll 1$  из (3) получим, что размер области обратного дифракционного отражения плоской волны:

$$x_{pl} \approx R_x \Delta\theta \approx R_x |\chi_{hr}|^{1/2}. \quad (4)$$

Видно, что при этом светосила дифрагированного пучка в  $|\chi_{hr}|^{-1/2}$  раз больше, чем при  $\theta_B \neq \pi/2$ . Заметим, что аналогичный геометрический подход к рассмотрению брэгговского отражения использовался в [4].

Иследуем теперь вопрос о распределении интенсивности в непосредственной окрестности изображения источника (фокуса). Заметим, что наряду с изгибом кристалла, при котором отражающая поверхность изгибается в форме параболического цилиндра ( $z \approx x^2/2R_x$ ), возможен и другой способ изгиба. Кристалл может быть изогнут с удержанием отражающей поверхности плоской ( $z \approx 0$ , см. [5]). В настоящей работе будет использована первая модель изгиба.

Исходя из геометрических соображений найдем:

$$\begin{aligned} L_{0,h}(x) = & L_{0,h(0)} [1 + x \sin \varphi_{0,h} L_{0,h(0)} + x^2 \alpha_{0,h} / 2L_{0,h(0)} \\ & - x^3 \sin \varphi_{0,h} \cos^2 \varphi_{0,h} / 2L_{0,h}^3 + x^3 \sin \varphi_{0,h} \cos \varphi_{0,h} / 2L_{0,h(0)}^2 R_x \\ & - x^4 / 8L_{0,h(0)}^4 + x^4 \sin^2 \varphi_{0,h} / 8R_x^2 L_{0,h(0)}^2 + x^4 \cos \varphi_{0,h} / 4L_{0,h(0)}^3 R_x \\ & + 3x^4 \sin^2 \varphi_{0,h} \{1/L_{0,h} - \cos \varphi_{0,h} / R_x\} / 4L_{0,h}^3. \end{aligned} \quad (5)$$

Здесь  $\cos \varphi_{0,h}$  — направляющие косинусы падающей и дифрагированной волн,  $L_{0,h(0)}$  — „безабберационные“ расстояния от источника сферической волны до кристалла и от кристалла до изображения соответственно;

$$\alpha_{0,h} = \cos^2 \varphi_{0,h} / L_{0,h(0)} - \cos \varphi_{0,h} / R_x. \quad (6)$$

Рассмотрим симметричное обратное рассеяние ( $\varphi_0 = \varphi_h = \pi/2 - \theta_B$ ). Учтем в (5) члены четвертого порядка только для дифрагированной волны. Используя динамическую теорию дифракции рентгеновского излучения в упруго-изогнутых кристаллах [5–7], найдем интенсивность дифрагированной волны вблизи точки  $\xi_p$  в непосредственной окрестности фокуса:

$$\begin{aligned} I_h(\xi_p) \sim & \left| \kappa^2 C \chi_{hr} \sigma_h (8\pi^{3/2} R_x^2 \sin^2 2\theta_B)^{-1} \right. \\ & \times \int dy R(y) \exp(-iy^2 \sigma_h^2 / 2\kappa \alpha_0) \int dx \exp \left[ i\kappa \{ \xi_p x / L_{h(0)} \right. \\ & \left. \left. - y \sigma_h x / \kappa + \alpha_h x^2 / 2 + x^4 (1/R_x - 1/2L_0) / 4L_0^2 \} \right] \right|^2. \quad (7) \end{aligned}$$

Здесь  $\kappa = 2\pi/\lambda$ ,  $C$  — поляризационный фактор,  $\sigma_h = \kappa \chi_h / 2 \cos \theta_B$ ,  $\lambda$  — длина волны падающего излучения,  $R(y)$  — амплитудный плосковолновой коэффициент отражения,  $y$  — нормированная угловая переменная [8].

Интеграл по  $x$  в (7) есть интеграл Пирси [9]. Тогда окончательно для интенсивности получим:

$$I_h(\xi_p) \sim 4 |\Phi(\kappa A_4)^{-1/4} R(y \approx 0) I_p^{y \approx 0}(A_1, A_2)|^2, \quad (8)$$

где  $\Phi$  — множитель в (7), стоящий перед интегралом по  $y$ ,

$$I_p(A_1, A_2) = \int \exp[i(A_2 t + A_1 t^2 + t^4)] dt \quad \text{— интеграл Пирси,}$$

$$A_1 = \kappa \alpha_h / \{2(\kappa A_4)^{1/4}\}, \quad A_2 = [\kappa \xi_p / L_{h(0)} - y \sigma_h / \kappa] / \{\kappa A_4\}^{1/4}, \quad (9)$$

$$A_4 = (1/R_x - 1/2L_0) / 4L_0^2.$$

В следующих случаях при  $L_0 = R_x/2$ , а также, если не учитывать члены  $\sim x^4$ , из (7) после взятия интеграла по  $x$  и по  $y$  и с учетом геометрического условия фокусировки  $\alpha_0 + \alpha_h = 0$  получаем:

$$I_h(\xi_p) \sim \left| \Phi \times J_1(\xi_p \sigma_h / \alpha_h L_{h(0)}) / (\xi_p \sigma_h / \alpha_h L_{h(0)}) \right|^2 \Theta(\xi_p / \alpha_h L_{h(0)}), \quad (11)$$

где  $J_1(t)$  — функция Бесселя первого порядка действительного аргумента,  $\Theta(q)$  — ступенчатая функция Хевисайда. Формула (11) совпадает с результатом, полученным авторами [10].

## Список литературы

- [1] Kohra K., Matsushita M. // *Z. Naturforsch.* 1972. V. 27A. P. 484.
- [2] Caticha A., Caticha-Ellis S. // *Phys. Rev (B)*. 1982. V. 25. P. 971.
- [3] Кушнир В.И., Суворов Э.В. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 48. В. 2. С. 109–111.
- [4] Чен Т., Бушуев В.А., Кузьмин Р.Н. // ЖТФ. 1990. В. 10. С. 60–63.
- [5] Габриелян К.Т., Чуховский Ф.Н., Пинскер З.Г. // ЖТФ. 1980. Т. 50. В. 1. С. 3–11.
- [6] Chukhovskii F.N., Gabrielyan K.T., Petrashen' P.V. // *Acta Cryst.* 1978. A34. P. 610–621.
- [7] Чуховский Ф.Н. // *Металлофизика*. 1981. Т. 3. В. 5. С. 3–30.
- [8] Пинскер З.Г. *Рентгеновская кристаллооптика*. М.: Наука, 1982. 392 с.
- [9] Pearsey T. // *Philos. Mag.* 1946. V. 37. P. 311.
- [10] Габриелян К.Т., Чуховский Ф.Н., Пискунов Д.И. // ЖЭТФ. 1989. Т. 96. В. 3 (9). С. 834–846.